【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和6年6月26日(2024.6.26)

【国際公開番号】WO2023/100694
【出願番号】特願2023-564889(P2023-564889)
【国際特許分類】
*G01N 27/28(2006.01)*
*G01N 27/327(2006.01)*
*G01N 27/414(2006.01)*
*G01N 27/30(2006.01)*
【FI】
G01N 27/28 331Z
G01N 27/327353Z
G01N 27/414301A
G01N 27/30 311Z

【手続補正書】
【提出日】令和6年4月3日(2024.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁基板と、
前記絶縁基板上に形成された参照電極とを備え、
前記参照電極は、
前記絶縁基板上に形成された銀層と、
前記銀層上から前記絶縁基板上に亘って形成されており、前記銀層を覆っている第１塩化銀層と、
前記第１塩化銀層上から前記絶縁基板上に亘って形成されており、
前記第１塩化銀層を覆っている第２塩化銀層とを含み、
任意の縦断面において、前記第１塩化銀層の面積空隙率は、前記第２塩化銀層の面積空隙率より大きい、電極基板。
【請求項２】
前記第１塩化銀層の面積空隙率は、１０％以上である、請求項１に記載の電極基板。
【請求項３】
前記第１塩化銀層の厚みと前記第２塩化銀層の厚みとの合計値に対する前記第１塩化銀層の厚みの比率は、２０％以上である、請求項１に記載の電極基板。
【請求項４】
前記第１塩化銀層の厚みと前記第２塩化銀層の厚みとの合計値は、２０μｍ以下である、請求項１に記載の電極基板。
【請求項５】
前記第２塩化銀層は、平均粒径が１μｍ以上の多結晶体で形成されている、請求項１に記載の電極基板。
【請求項６】
前記絶縁基板上に形成された金属配線層をさらに備え、
前記銀層は、前記金属配線層上から前記絶縁基板上に亘って形成されて前記金属配線層

の少なくとも一部を覆っている、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の電極基板。

【請求項７】

前記銀層は、多結晶体で形成されている、請求項６に記載の電極基板。

【請求項８】

前記銀層は、めっき膜である、請求項６に記載の電極基板。

【請求項９】

前記銀層は、前記金属配線層の一部のみを覆っており、

前記金属配線層において前記銀層に覆われていない部分によって、前記絶縁基板上に形成された一対の電極が構成されている、請求項６に記載の電極基板。

【請求項１０】

前記一対の電極は、前記絶縁基板に形成された半導体チャネルに接合されている、請求項９に記載の電極基板。